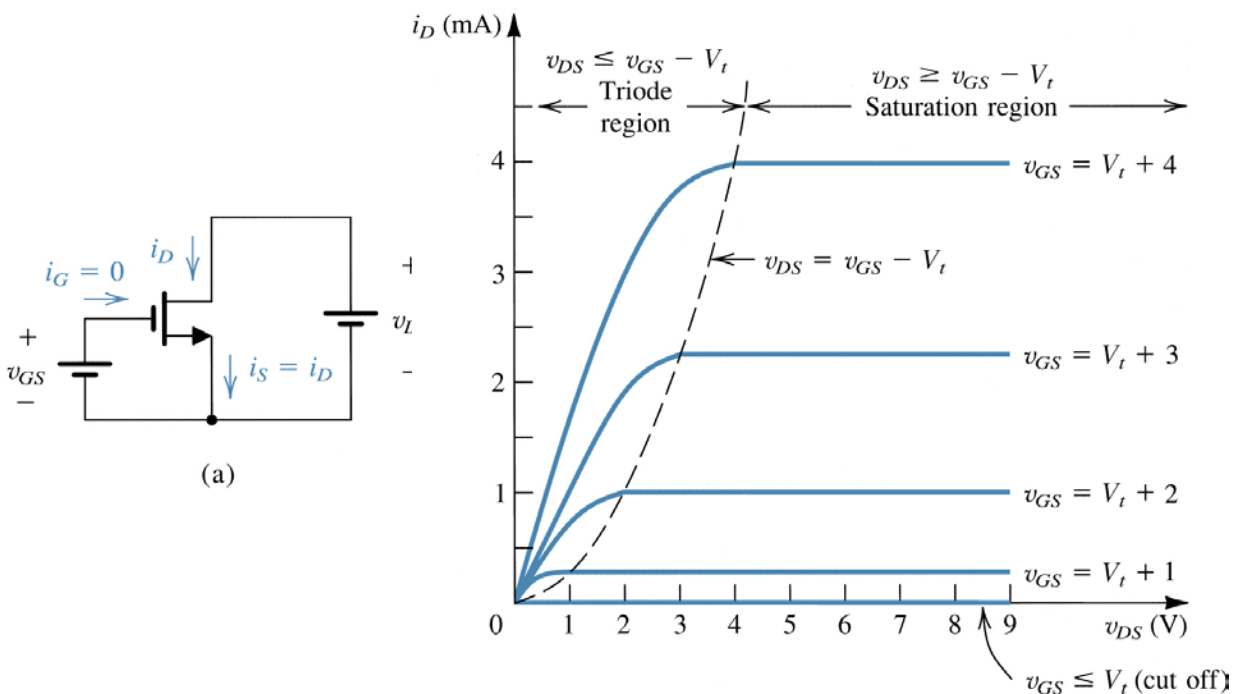


Corrente di *drain* I_D in funzione della tensione V_{DS} per un transistor NMOS ad arricchimento funzionante con $V_{GS} > V_{TH}$.



(a) Transistor MOSFET ad arricchimento di tipo n polarizzato. (b) Caratteristiche di uscita I_D - V_{DS} per un dispositivo con $V_{TH} = 1\text{ V}$ e $k_n (W/L) = 0.5\text{ mA/V}^2$.